

表 目 錄

編號	名稱	頁次
表 1-1	各篇論文參數的比較和整理。.....	9
表 2-1	氧化矽、AEAPTMS 和硒化鎘三種不同比的的粗操度。.....	20
表 2-2	硼參雜後的四點探針測量結果。.....	31
表 2-3	磷參雜後的四點探針測量結果。.....	31
表 3-1	所有元件的臨界電壓的平均和誤差表。.....	39
表 3-2	所有元件的次臨界斜率的平均和誤差的比較。.....	41
表 3-3	所有元件的開關電流比的平均和誤差的比較。.....	42
表 3-4	金奈米粒子(Au)記憶體，寫入電壓對應之臨界電壓偏移。.....	46
表 3-5	硒化鎘奈米粒子記憶體，寫入電壓對應之臨界電壓偏移。.....	46
表 3-6	金加硒化鎘奈米粒子記憶體，寫入電壓對應之臨界電壓偏移。.....	46
表 3-7	HEI 以及 FN 的操作參數。.....	48
表 3-8	各種金屬半導體的蕭特基位障。.....	62
表 3-9	本實驗元件和其他三片論文之比較。.....	63